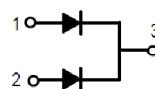


## Super Fast Recovery Diode, 200A

Features

- Dual Diode Construction
- Low Leakage Current
- Low forward voltage drop
- High surge current capability
- Super Fast Switching



TWIN TOWER PACKAGE

**Maximum Ratings ( $T_J = 25^\circ\text{C}$  unless otherwise specified)**

Parameter	Symbol	Conditions	MUR20040CT(R)	MUR20060CT(R)	Units
Repetitive peak reverse voltage	$V_{RRM}$		400	600	V
RMS reverse voltage	$V_{RMS}$		280	420	V
DC blocking voltage	$V_{DC}$		400	600	V
Average forward current	$I_{F(AV)}$	$T_c \leq 140^\circ\text{C}$	200	200	A
Non-repetitive forward surge current, half sine-wave	$I_{FSM}$	$T_c = 25^\circ\text{C}$	800	800	A

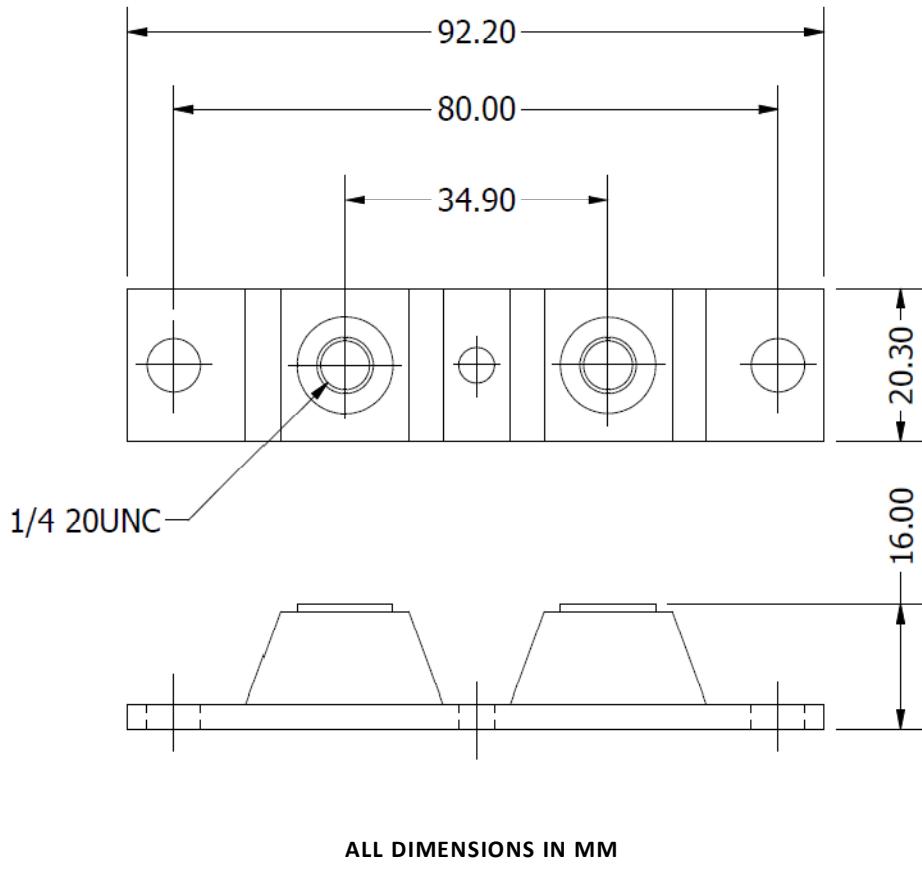
**Electrical Characteristics ( $T_J = 25^\circ\text{C}$  unless otherwise specified)**

Parameter	Symbol	Conditions	MUR20040CT(R)	MUR20060CT(R)	Units
DC forward voltage	$V_F$	$I_F = 50\text{ A}$ $T_J = 25^\circ\text{C}$	1.3	1.7	V
DC reverse current	$I_R$	$V_R = 50\text{ V}$ $T_J = 25^\circ\text{C}$	25	25	$\mu\text{A}$
		$V_R = 50\text{ V}$ $T_J = 125^\circ\text{C}$	1	1	mA
Maximum Reverse Recovery Time	$t_{rr}$	$I_F = 0.5\text{A}$ $I_R = 1.0\text{A}$ $I_{RR} = 0.25\text{A}$	90	110	nS

**Thermal Characteristics ( $T_J = 25^\circ\text{C}$  unless otherwise specified)**

Parameter	Symbol		MUR20040CT(R)	MUR20060CT(R)	Units
Thermal resistance junction to case	$R_{thJ-C}$		1.0	1.0	$^\circ\text{C/W}$
Operating, storage temperature range	$T_J, T_{stg}$		- 40 to +175	- 40 to +175	$^\circ\text{C}$

## Package Outline



## Ordering Table

MUR	200	40	CT
1	2	3	4

1 – Device Type

> MUR = Dual Diode Recovery Module

2 – Current Rating =  $I_{F(AV)}$

3 – Voltage = code x 10 =  $V_{RRM}$

4 – Polarity

- > CT = Normal (Cathode to Base)
- > CTR = Reverse (Anode to Base)

**Данный компонент на территории Российской Федерации****Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибуторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р В 0015-002 и ЭС РД 009

**Офис по работе с юридическими лицами:**

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru  
moschip.ru\_4

moschip.ru\_6  
moschip.ru\_9